

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 19 年 1 月 18 日 (2007.1.18)

【公開番号】特開 2005-136437 (P2005-136437A)

【公開日】平成 17 年 5 月 26 日 (2005.5.26)

【年通号数】公開・登録公報 2005-020

【出願番号】特願 2005-288 (P2005-288)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/304 (2006.01)

H 0 1 L 21/02 (2006.01)

H 0 1 L 21/677 (2006.01)

H 0 1 L 21/673 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/304 6 4 8 J

H 0 1 L 21/304 6 4 2 E

H 0 1 L 21/304 6 4 7 B

H 0 1 L 21/304 6 4 7 Z

H 0 1 L 21/304 6 4 8 L

H 0 1 L 21/02 D

H 0 1 L 21/68 A

H 0 1 L 21/68 V

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 11 月 22 日 (2006.11.22)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

半導体基板の室温洗浄装置と、洗浄後の半導体基板を処理する処理装置とを、隣接するように配置したことを特徴とする半導体製造システム。

【請求項 2】

前記半導体基板の洗浄装置並びに洗浄後の半導体基板を処理する処理装置が、略々プロセス順に配置された請求項 1 に記載の半導体製造システム。

【請求項 3】

フォトリソグラフィ装置及び室温洗浄装置を分散配置することにより、半導体基板の搬送距離を略々最短ならしめたことを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の半導体製造システム。

【請求項 4】

前記フォトリソグラフィ装置、前記室温洗浄装置及び前記処理装置の間をクリーン N₂あるいはクリーン N₂/O₂雰囲気搬送装置で接続したことを特徴とする請求項 1 ~ 3 のいずれか 1 項に記載の半導体製造システム。

【請求項 5】

前記処理装置は、不純物導入装置、酸化・拡散装置、CVD 装置、プラズマ CVD 装置、スパッタ装置、RIE 装置のいずれかであることを特徴とする請求項 1 ~ 4 のいずれか 1 項に記載の半導体製造システム。